

ОТЧЕТ О ВЕРИФИКАЦИИ SPICE-МОДЕЛИ ДИОДА MURH840CTG

Общее описание

В этом отчете будут описаны характеристики SPICE-модели диода **MURH840CTG**, которые верифицированы с помощью моделирования.

Среда моделирования

- Система моделирования: *LTSpice XVII*.
- Информация о версии: 17.0.34.0.
- Информация об операционной системе: 64-разрядная версия Windows 10.

Информация о файле

- Имя файла библиотеки: MURH840CTG.lib
- Источник: Model Microcap

ВНИМАНИЕ

- Характеристики модели рассчитаны с учетом температуры, равной $T = 25$ °C. Таким образом, результат моделирования с отклонениями температуры может значительно отличаться от результата, полученного
- Результат моделирования и характеристики, описанные в этом отчете, могут отличаться в зависимости результатов верификации.
- Значения, полученные в результате моделирования, не гарантируются. Используйте эти результаты в качестве руководства при проектировании.

MURH840CTGSpice-модель

```
.MODEL MURH840CTG D (IS=480.614N N=2.5 BV=500 RS=75.7043M TT=5U CJO=205.981P  
+ VJ=700M M=578.86M)
```

ВЕРИФИЦИРУЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электрические характеристики (в сравнении с техническим паспортом):
 - Зависимость прямого тока от напряжения на диоде.
 - Зависимость барьерной емкости диода от обратного напряжения.

Характеристики SPICE-модели в сравнении с приведенными в техническом паспорте

1. Зависимость прямого тока от напряжения на диоде

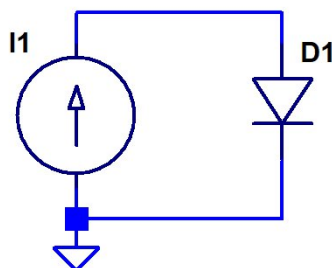


Рис. 1. Электрическая схема моделирования

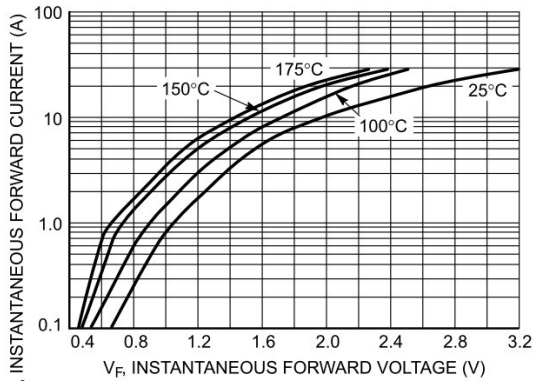


Рис. 2. Данные технического паспорта

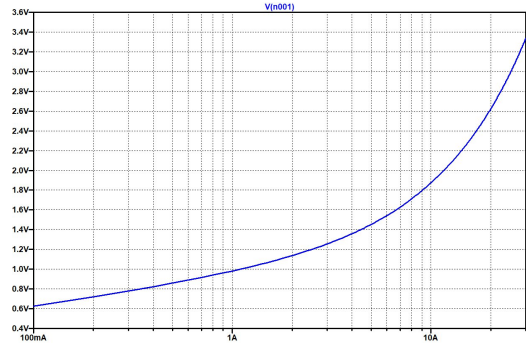


Рис. 3. Результаты моделирования

Таблица 1. Сравнение характеристик

Параметр		Данные техпаспорта	Данные моделирования	Единицы	Ошибка	Условия
V	0.1	0.657	0.624	В	5%	I1 0.1 - 30A
	15.5	23.97	22.9		4.4%	

2. Зависимость барьерной емкости диода от обратного напряжения.

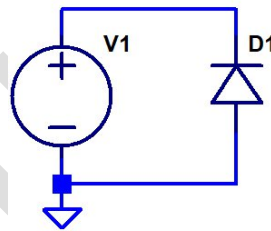


Рис.7. Электрическая схема моделирования

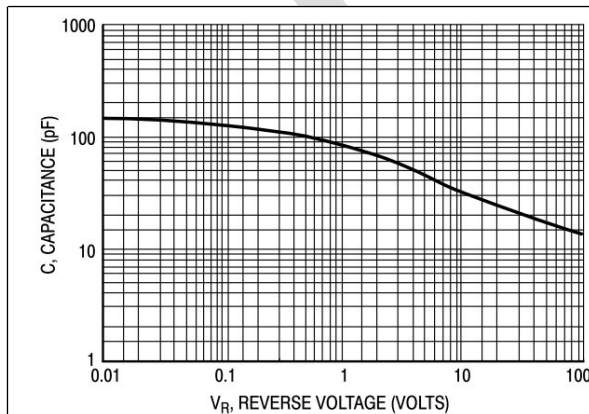


Рис.8. Данные технического паспорта

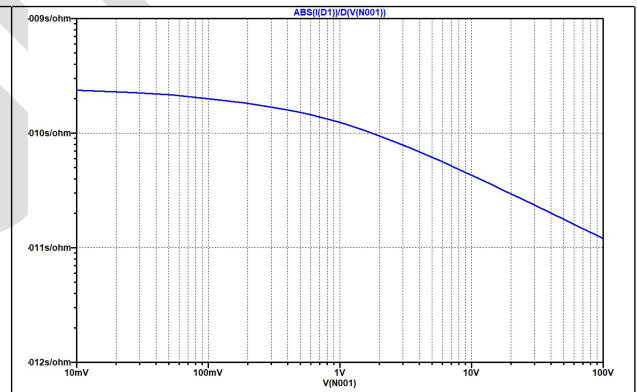


Рис. 9. Результаты моделирования

Таблица 3. Сравнение характеристик

Параметр		Данные техпаспорта	Данные моделирования	Единицы	Ошибка	Условия
C	10мВ	212	236	пФ	11%	
	11В	42.6	41		3.7%	